

Silicon Diode

LL4154

25V / 200mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

LL 4154

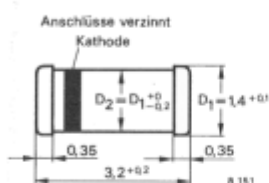
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Besondere Merkmale:

- Elektrische Daten entsprechen denen des Typs 1N 4154

Abmessungen in mm



Glasgehäuse
SOD 80
MiniMELF
Gewicht max. 0,1 g

Absolute Grenzdaten

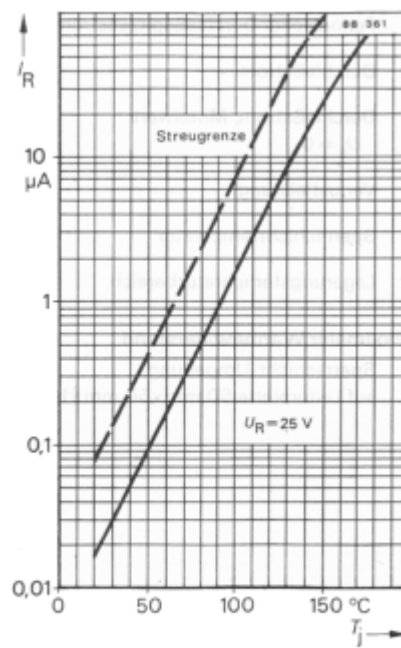
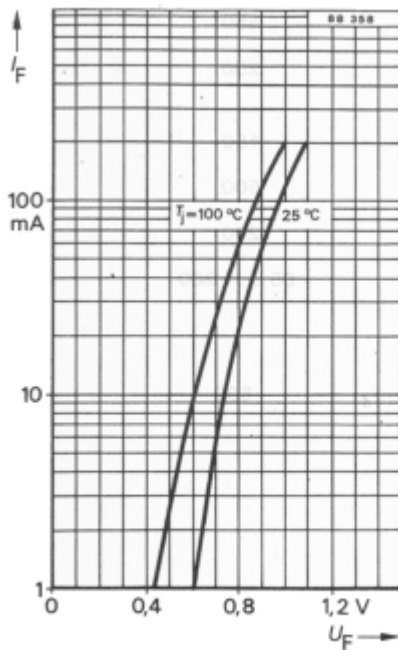
Periodische Spitzensperrensorgung	U_{RRM}	35	V
Sperrspannung	U_R	25	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 1 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	450	mA
Durchlaßstrom	I_F	200	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert $U_R = 0$	I_{FAV}	150	mA
Verlustleistung	P_V	500	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 200	°C

Maximaler Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}	500	K/W
--	------------	-----	-----

LL 4154

Kenngrößen	Min.	Typ.	Max.
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben			
Durchlaßspannung $I_F = 30\text{ mA}$			1 V
Sperrstrom $U_R = 25\text{ V}$			100 nA
$U_R = 25\text{ V}, T_j = 150\text{ °C}$			100 μA
Durchbruchspannung $I_R = 5\text{ }\mu\text{A}$	35		V
Diodenkapazität $U_R = 0, f = 1\text{ MHz}, U_{HF} = 50\text{ mV}$			4 pF
Rückwärtserholzeit $I_F = I_R = 10\text{ mA}, I_R = 1\text{ mA}$			4 ns
$I_F = 10\text{ mA}, U_R = 6\text{ V}$			
$I_R = 0,1 \cdot I_{Rr}, R_L = 100\text{ }\Omega$			2 ns



$${}^1) \frac{t_p}{T} = 0,01, t_p = 0,3\text{ ms}$$

LL 4154